

# Silicon Diode

## **BAX82**

50V / 250mA / 400mW

# DATASHEET

OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

BAX82

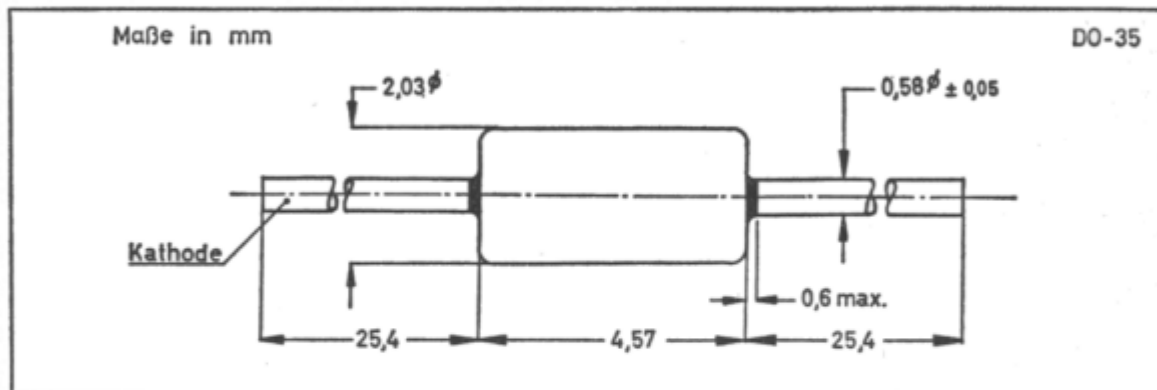
**Planar-Silizium-Diode im DO-35-Gehäuse für allgemeine Anwendungen****Niedere Schaltzeiten bei hohen Durchlaßströmen****Miniaturbauweise aus nur 4 Einzelteilen****Widerstandsfähig gegen extreme mechanische Beanspruchungen****Mechanische Daten**

Mechanischer Schock 3000 g über 0,2 ms

3 Ebenen

Beschleunigen 20000 g über 1 min/Ebene

6 Ebenen

**Absolute Grenzwerte**

Sperrspannung	50 V
Spitzensperrspannung	50 V
Durchlaßstrom	250 mA
Spitzenstrom bei 1 s Pulsbreite	400 mA
Stoßstrom bei 1 $\mu$ s Pulsbreite	3 A
Sperrschichttemperatur	175 °C
Lagerungstemperatur	-65 °C bis +200 °C
Verlustleistung	400 mW
Wärmewiderstand	0,375 °C/mW

**Statische Kennwerte bei  $T_U = 25\text{ °C}$  (wenn nicht anders angegeben)**

Parameter	Prüfbedingung	min	typ	max	
$U_{BR}$	$I_R = 5\ \mu\text{A}$	50			V
$U_F$	$I_F = 100\ \mu\text{A}$	0,40	0,46	0,53	V
	$I_F = 1\ \text{mA}$	0,50	0,57	0,67	V
	$I_F = 10\ \text{mA}$	0,60	0,70	0,85	V
	$I_F = 100\ \text{mA}$	0,75	0,90	1,10	V
	$I_F = 200\ \text{mA}$	0,82	1,10	1,35	V
$I_R$	$U_R = 30\ \text{V}$		20	100	nA
$I_R$	$U_R = 30\ \text{V}$				
	$T_U = 100\text{ °C}$		1,5	10	$\mu\text{A}$
$I_R$	$U_U = 30\ \text{V}$				
	$T_R = 150\text{ °C}$		25	100	$\mu\text{A}$
C	$U_R = 0\ \text{V}$		2,5	3,5	pF
$t_{rr}$	$I_F = 10\ \text{mA}$				
	$I_R = 10\ \text{mA}$				
	bis auf $I_R = 1\ \text{mA}$		4	6	ns
$t_{rr}$	$I_F = 200\ \text{mA}$				
	$I_R = 200\ \text{mA}$				
	bis auf $I_R = 20\ \text{mA}$		5	8	ns

